isc Silicon NPN Power Transistor

MJE2801T

DESCRIPTION

- Collector-Emitter Breakdown Voltage-
- : $V_{(BR)CEO} = 60V(Min)$
- · High DC Current Gain-
 - : h_{FE}= 25-100@I_C= 3A
- Complement to Type MJE2901T

APPLICATIONS

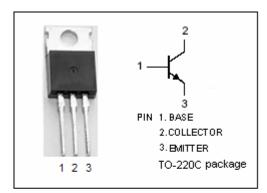
 Designed for use as an output device in complementary audio amplifiers up to 35 watts music power per channel.

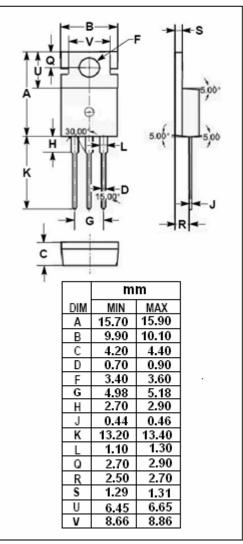
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(T_a=25℃)

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT	
V _{CBO}	Collector-Base Voltage	age 60		
V _{CEO}	Collector-Emitter Voltage 60		V	
V _{EBO}	Emitter-Base Voltage 4		V	
Ic	Collector Current-Continuous 10		А	
I _B	Base Current-Continuous	5	А	
Pc	P _C Collector Power Dissipation @ T _C =25°C		W	
TJ	Junction Temperature 150		°C	
T _{stg}	Storage Temperature Range -55~150		$^{\circ}$	

THERMAL CHARACTERISTICS

SYMBOL	PARAMETER	MAX	UNIT
R _{th j-c}	Thermal Resistance,Junction to Case	1.67	°C/W





isc Silicon NPN Power Transistor

MJE2801T

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 $T_C=25^{\circ}C$ unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP.	MAX	UNIT
V _{(BR)CEO}	Collector-Emitter Breakdown Voltage	I _C = 200mA; I _B = 0	60			V
V _{CE(sat)}	Collector-Emitter Saturation Voltage	I _C = 4A; I _B = 0.4A			1.1	V
V _{BE(on)}	Base-Emitter On Voltage	I _C = 3A ; V _{CE} = 2V			1.4	V
I _{CBO}	Collector Cutoff Current	V _{CB} = 60V; I _E = 0 V _{CB} = 60V; I _E = 0;T _C = 150℃			0.1 2.0	mA
I _{EBO}	Emitter Cutoff Current	V _{EB} = 4V; I _C =0			1.0	mA
h _{FE}	DC Current Gain	Ic= 3A ; V _{CE} = 2V	25		100	

2

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru_4 moschip.ru_9